

圖 6-37 Via-1 洞孔之形成。

(3)以 PVD 的方式沉積一層薄的鈮 (Ta) 作為黏合層 (adhesion layer)，再將氮化鈮 (TaN) 沉積於 Ta 之上，作為之後沉積 Cu 金屬的擴散阻擋層，如圖 6-38 所示。

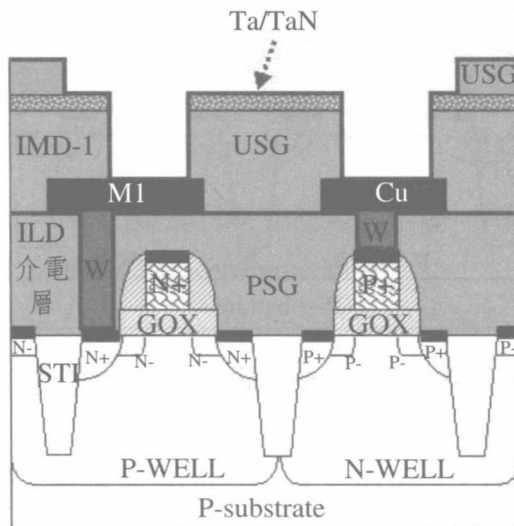


圖 6-38 Ta 和 TaN 之形成。